

BACK-END

MOS-FET

IGBT

DIODE

GaN FET

THERMAL RESISTANCE TESTER 過渡熱抵抗測定器

THR1050Z

1000V
500A

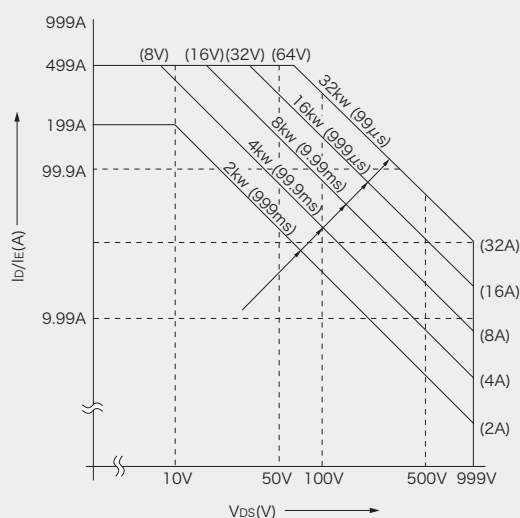
● THR1050Z has high power specifications with a maximum applied of 32 kW, and is ideal as a thermal analysis for power devices. This system is designed to measure MOS-FET, IGBT, diode, as well as GaN-FET. For temperature sensor measurements using thermocouples, the software displays measured temperatures up to 400°C.

● THR1050Z は最大印加 32kW の高出力仕様でパワーデバイスの熱解析システムとして最適のシステムです。MOS-FET、IGBT、ダイオードのほか GaN-FET の測定にも対応しています。熱電対を使用した温度検出機測定では 400°C までの測定温度をソフトウェア上に表示します。

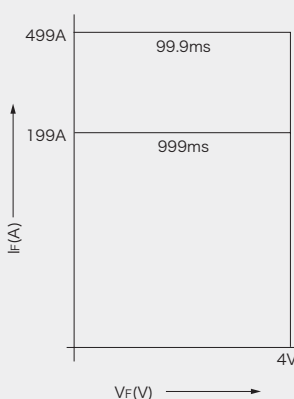


Forcing Power Range Diagram

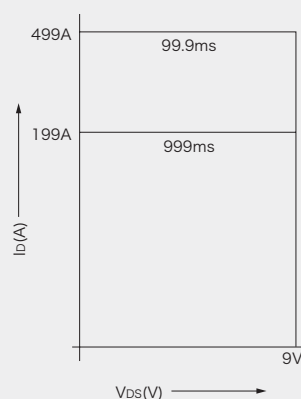
【MOS-FET, IGBT, GaN FET】



【DIODE】



【MOS-FET (ΔVSDL)】



MODEL

THR1050Z

MEASUREMENT RANGE

VGE1/VGS1	0000mV~9999mV
ΔVGE/ΔVGS	0000mV~±1999mV
VSD1/VCE1/VF1/VSDL1	0000.0mV~3200.0mV
ΔVSD/ΔVCE/ΔVF/ΔVSDL	000.0mV~±999.9mV
【DIODE】VP1/VP2	0.000V~4.000V(Read only on PC [PCでのみ検出])
TH(TEMPERATURE DETECTION)	000.0°C~400.0°C(Read only on PC [PCでのみ検出])

SETTING RANGE

MEASURABLE DEVICES	MOS FET, IGBT, DIODE, GaN FET
Vds/VCE	1V~999V
Vds(ΔVSDL TEST)	1V~9V
Id/IC/IF	0.01A~499.00A
IM	1mA~199mA
GATE OFF VOLTAGE	-0.5V~20.0V
POWER FORCING TIME(PT)	10μs~999ms
DELAY TIME(DT)	10μs~999μs
LOWER GATE(LG)/UPPER GATE(UG)	0000mV~1999mV or 000.0mV~999.9mV

DIMENSIONS & WEIGHT

UNIT-A	550(W)×1060+Safety cover 370(D)×1800(H) ...510kg
UNIT-B	550(W)×1060(D)×1800(H) ...550kg

Self-Check Function (自己診断機能)

ソフトウェアを使用し自己診断を行うことができます。
電圧や電流を設定し、測定器内で値を読み取ります（自己診断時は測定端子部に電圧および電流は出力されません）。
また、検出値に対して上限、下限を設定することができます。

- ① VCB/Vds/VCE Voltage
- ② IE/Id/IC/IF Current
- ③ IM Current